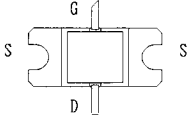
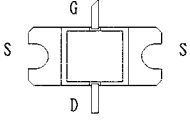
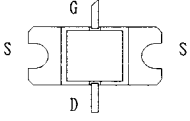
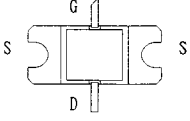
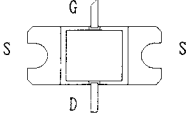


一般項目	最大定格		電 氣 的 特 性				備 考	ピン接続図
	項目	定格値	項目	最小	標準	最大		
●MGFK25M4045 三菱 用途: SHF(14.0~14.5GHz)帯電力増幅用 構造: インピーダンス整合回路内蔵 GaAs FET. 特長: 高出力 ($P_{1dB}=0.3W$, 標準)。高直線利得。	$V_{DD}(V)$	-14	$I_{DSS}(mA)$	200.00	300.00	400.00	$V_{DS}=3V, V_{GS}=0$	
	$V_{GS0}(V)$	-14	$g_m(mS)$	70.00	100.00		$V_{DS}=3V, I_D=150mA$	
	$I_D(mA)$	400						
	$P_T(W)$	3	$GLP(dB)$	7.00	8.00		P_{1dB} に同じ。	
	$Tch(^{\circ}C)$	175	$\eta_{add}(\%)$		25.00		P_{1dB} に同じ。	
	$Rth(ch-c)=40^{\circ}C/W$		$P_{1dB}(W)$	0.20	0.30		$V_{DS}=10V, I_D=150mA, f=14.0\sim 14.5GHz$	
●MGFK30M4045 三菱 用途: SHF(14.0~14.5GHz)帯電力増幅用 構造: インピーダンス整合回路内蔵 GaAs FET. 特長: 高出力 ($P_{1dB}=1.1W$, 標準)。高直線利得。	$V_{DD}(V)$	-14	$I_{DSS}(A)$	0.60	0.90	1.20	$V_{DS}=3V, V_{GS}=0$	
	$V_{GS0}(V)$	-14	$g_m(mS)$	210.00	300.00		$V_{DS}=3V, I_D=450mA$	
	$I_D(A)$	1						
	$P_T(W)$	7	$GLP(dB)$	6.00	7.00		P_{1dB} に同じ。	
	$Tch(^{\circ}C)$	175	$\eta_{add}(\%)$		24.00		P_{1dB} に同じ。	
	$Rth(ch-c)=20^{\circ}C/W$		$P_{1dB}(W)$	0.90	1.10		$V_{DS}=8V, I_D=450mA, f=14.0\sim 14.5GHz$	
●MGFK33M4045 三菱 用途: SHF(14.0~14.5GHz)帯電力増幅用 構造: インピーダンス整合回路内蔵 GaAs FET. 特長: 高出力 ($P_{1dB}=2.0W$, 標準)。高直線利得。	$V_{DD}(V)$	-14	$I_{DSS}(A)$	1.20	1.80	2.40	$V_{DS}=3V, V_{GS}=0$	
	$V_{GS0}(V)$	-14	$g_m(mS)$	420.00	600.00		$V_{DS}=3V, I_D=900mA$	
	$I_D(A)$	2						
	$P_T(W)$	15	$GLP(dB)$	5.50	6.50		P_{1dB} に同じ。	
	$Tch(^{\circ}C)$	175	$\eta_{add}(\%)$		22.00		P_{1dB} に同じ。	
	$Rth(ch-c)=10^{\circ}C/W$		$P_{1dB}(W)$	1.60	2.00		$V_{DS}=8V, I_D=900mA, f=14.0\sim 14.5GHz$	
●MGFK35M4045 三菱 用途: SHF(14.0~14.5GHz)帯電力増幅用 構造: インピーダンス整合回路内蔵 GaAs FET. 特長: 高出力 ($P_{1dB}=3.5W$, 標準)。高直線利得。	$V_{DD}(V)$	-14	$I_{DSS}(A)$	2.50	3.30	4.50	$V_{DS}=3V, V_{GS}=0$	
	$V_{GS0}(V)$	-14	$g_m(S)$	0.80	1.20		$V_{DS}=3V, I_D=1.6A$	
	$I_D(A)$	4						
	$P_T(W)$	30	$GLP(dB)$	5.00	6.00		P_{1dB} に同じ。	
	$Tch(^{\circ}C)$	175	$\eta_{add}(\%)$		20.00		P_{1dB} に同じ。	
	$Rth(ch-c)=5^{\circ}C/W$		$P_{1dB}(W)$	2.80	3.50		$V_{DS}=8V, I_D=1.6A, f=14.0\sim 14.5GHz$	
●MGFK35V4045 三菱 用途: SHF(14.0~14.5GHz)帯電力増幅用 構造: インピーダンス整合回路内蔵 GaAs FET. 特長: 高出力 ($P_{1dB}=3.5W$, 標準)。高直線利得。	$V_{DD}(V)$	-15	$I_{DSS}(A)$	2.00	2.70	3.50	$V_{DS}=3V, V_{GS}=0$	
	$V_{GS0}(V)$	-15	$g_m(S)$	0.70	1.00		$V_{DS}=3V, I_D=1.2A$	
	$I_D(A)$	3						
	$P_T(W)$	33	$GLP(dB)$	5.50	6.50		P_{1dB} に同じ。	
	$Tch(^{\circ}C)$	175	$\eta_{add}(\%)$		20.00		P_{1dB} に同じ。	
	$Rth(ch-c)=4.5^{\circ}C/W$		$P_{1dB}(W)$	2.80	3.50		$V_{DS}=10V, I_D=1.2A, f=14.0\sim 14.5GHz$	